



ФИЗИКО – МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ



Ф.И.О. Кутлиев Учкун Отобоеевич
ДОЛЖНОСТЬ зав.кафедрой
ТЕЛ: +99893-9221672
E – mail: uchkunk@mail.ru
ТЕЛЕФОН
ОРГАНИЗАЦИИ: +99862 2246700
АДРЕС
ОРГАНИЗАЦИИ: г.Ургенч, ул.Х.Олимджана 14. 220100

ОБРАЗОВАНИЕ, СТЕПЕНЬ	<p>1989- 1994: Ташкентский государственный технический университет, факультет радиоэлектриники и автоматики, диплом физик-инженера.</p> <p>1995-1998 : Аспирант в институте Электроники АН РУз</p> <p>1999- Диплом кандидата физико-математических наук. (01.04.04- физическая электроника)</p> <p>2010- Диплом Доктора наук по специальности физическая электроника (01.04.04)</p>
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:	<p>1994 – 1995: стажёр-исследователь в институте Электроники АН РУз</p> <p>1998 - 1999: младший научный сотрудник стажёр-исследователь в институте Электроники АН РУз</p> <p>2000- 2001: Начальник научного отдела Ургенчского государственного университета.</p> <p>2002- 2005: зав.кафедрой Ургенчского государственного университета.</p> <p>2005-2010: доцент Ургенчского государственного университета.</p> <p>2010-2011: зав.кафедрой Ургенчского государственного университета.</p> <p>2011-2012: директор Ургенчского филиала ТУИТ</p> <p>2012-2013: доцент Ургенчского государственного университета.</p> <p>2013-2015: зав.кафедрой Ургенчского государственного университета</p> <p>2015-2017: доцент Ургенчского государственного университета</p> <p>2017- н.в. зав.кафедрой Ургенчского государственного университета</p>
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ	<ul style="list-style-type: none">• Физика.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ	<ul style="list-style-type: none">• Электр и магнетизм, Основы электроники полупроводников, Теория колебаний
ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:	Моделирование процесса рассеяния ионов с поверхность твёрдого тела,
ПРОЕКТЫ:	<p>2002, Pensilvaniya universiteti posdoc</p> <p>2003. INTAS</p>

	<p>2003, Vienna technology university grant</p> <p>2004, Cambridge hospitality grant</p> <p>2005. Brussels Universiteti postdoc</p> <p>2017-2020, OT-Ф2-65 “Исследования закономерностей рассеяния моноэнергетических ионов с поверхностью полупроводников типа Al₂IBV”</p>
ПУБЛИКАЦИИ	<p>1.Kutliev U.O., Karimov M.K., Kuryozov F.O., Otobaeva K.U. Analysis of InGaP(001) surface by the low energy ion scattering spectroscopy // Journal of Physics: Conference Series, 2021. – Volume. 1889. (№3 Scopus, IF = 0.7), (01.00.00; №16)</p> <p>2.Karimov M.K., Kutliev U.O., Otobaeva K.U., Otobaev M.U. Angular Distributions of Scattered Ne and Ar Ions at the Grazing Incidence on the InGaP (001) <110> Surface // Journal of Nano- and Electronic Physics, 2020. – Volume.12, No.5. 05032(4pp). (№3 Scopus, IF = 1.1)</p> <p>3.Kutliev U.O., Karimov M.K., Otaboev M.U. Orientation Effects during Scattering of Ar+ Ions from the InP(001) Surface under Grazing-Angle Ion Bombardment // Inorganic Materials: Applied Research, 2020. – V.11, No.3. – pp. 503–506. (№3 Scopus, IF = 1.1)</p> <p>4.Karimov M.K., Kutliev U.O., Ismailov Sh.K., Otobaev M.U. Low Energy Ar+ Ion Scattering on InGaP(001) Surface // e-Journal of Surface Science and Nanotechnology, 2020. – Volume.18, – pp.164 – 167. (№3 Scopus, IF = 1.0)</p> <p>5.Karimov M.K., Matchonov Kh.J., Otaboeva K.U., Otaboev M.U. Computer Simulation of Scattering Xe+ Ions from InP(001)<110> Surface at Grazing Incidence // e-Journal of Surface Science and Nanotechnology, 2019. V.17, pp.179-183. (№3 Scopus, IF = 0.9)</p> <p>6.Каримов М.К., Кутлиев У.О., Отабоева К.У., Отабоев М.У. Вычисление неупругих потерь энергии при ионно – атомном столкновении // Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан официальный бюллетень, 2019. DGU 06100. 3(215). – С.320.</p> <p>7.Kutliev U., Karimov M., Sadullaeva B., Otaboev M. Investigation of the ion scattering process from the A3B5 semiconductors by the computer simulation method // COMPUSOFT, An international journal of advanced computer technology, 2018. – Volume. 7, No.4. – pp. 2749 – 2751. (№3 Scopus)</p> <p>8.Karimov M.K., Tangriberganov I.U., Qurbanov M.K., KutlievU.O., Otaboev M. U. Angular and energy distributions of low – energy argon ions at the scattering from Al₂IBV semiconductor surface // Actual problems of modern science, education and training in the region, 2018. – Volume. 3, No.2. – pp. 5–15. (01.00.00; №10)</p> <p>9.Кутлиев У.О., Каримов М.К., Отабоев М.У., Балтаева М.М. Определения энергии одно – идвукратно рассеянных ионов поверхностей твёрдого тела // Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан официальный бюллетень, 2018. DGU 05605. 9(209). – С.275.</p>